

$V_{RRM}$	Höchstzulässige periodische Spitzensperrspannung in Rückwärtsrichtung	Max. repetitive peak reverse blocking voltage
$V_{DRM}$	Höchstzulässige periodische Spitzensperrspannung in Vorwärtsrichtung	Max. repetitive peak forward blocking voltage
$V_{GT}$	Mindestzündspannung, $T_{VJ} = 25\text{ °C}$ (Oberer Zündspannung)	Minimum gate trigger voltage, $T_{VJ} = 25\text{ °C}$
$V_F$	Max. Durchlaßspannung einer Diode bei Durchlaßstrom $i_F$	Forward voltage drop of a diode, max. value at forward current $i_F$
$V_T$	Max. Durchlaßspannung eines Thyristors bei Durchlaßstrom $i_T$	Forward voltage drop of a thyristor, max. value at forward current $i_T$
$V_{TO}$	Schleusenspannung $T_{VJ} = T_{VJM}$	Threshold voltage $T_{VJ} = T_{VJM}$
$V_D$	Abgegebene Gleichspannung	DC - output voltage
$(dv/dt)_c$	Kritische Spannungssteilheit in Vorwärtsrichtung bei $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , linearer Anstieg $T_{VJ} = T_{VJM}$ offener Steuerkreis	Critical rate of rise of forward voltage at $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , linear rise $T_{VJ} = T_{VJM}$ gate open-circuit
$(dv/dt)_{com}$	Kritische Anstiegsgeschwindigkeit der Kommutierungsspannung bei $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$	Critical rate of rise of commutation voltage at $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$
$I_{FAVM}$	Dauergrenzstrom eines Diodenzweiges, arithmetischer Mittelwert für Sinus-halbwellen bei $T_C$	Mean forward current of a diode leg, for half sine waves at $T_C$
$I_{TAVM}$	Dauergrenzstrom eines Thyristorzweiges, arithmetischer Mittelwert für Sinus-halbwellen bei $T_C$	Mean forward current of a thyristor leg, for half sine waves at $T_C$
$I_{RRM}$	Periodischer Spitzensperrstrom in Rückwärtsrichtung bei $T_{VJM}$ und $V_{RRM}$	Repetitive peak reverse current at $T_{VJM}$ and $V_{RRM}$
$I_{FRMS}$	Höchstzulässiger Effektivstrom einer Diode	Maximum allowable RMS-current of a diode
$I_{TRMS}$	Höchstzulässiger Effektivstrom eines Thyristors	Maximum allowable RMS-current of a thyristor
$I_{FSM}$	Stoßstromgrenzwert für 10 ms, nicht periodisch, $V_R \leq 10\text{ V}$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$	Surge forward current at 10 ms, non-repetitive $V_R \leq 10\text{ V}$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$
$I_{TSM}$	Stoßstromgrenzwert für 10 ms, nicht periodisch, $V_R \leq V$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$	Surge forward current at 10 ms, non-repetitive $V_R \leq V$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$
$I^2t$	Grenzlastintegral für 10 ms, nicht periodisch, $V_R \leq 10\text{ V}$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$	$I^2t$ -value for fusing, 10 ms, non-repetitive, $V_R \leq 10\text{ V}$ , $T_{VJ} = T_{VJM}$
$I_{GT}$	Mindestzündstrom, $T_{VJ} = 25\text{ °C}$	Minimum gate trigger current, $T_{VJ} = T_{VJM}$
$I_H$	Haltestrom bei $T_{VJ} = T_{VJM}$	Holding current at $T_{VJ} = 25\text{ °C}$
$I_{FIOV}$	Zulässiger Überstrom	Permissible overload current
$(di/dt)_c$	Höchstzulässige Stromsteilheit (in Vorwärtsrichtung) $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , linearer Anstieg $T_{VJ} = T_{VJM}$ , $f = 50\text{ Hz}$ , $I_{TM} = 2 I_{TAVM}$	Critical rate of rise on on-state current $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , linear rise $T_{VJ} = T_{VJM}$ , $f = 50\text{ Hz}$ , $I_{TM} = 2 I_{TAVM}$
$r_F$	Ersatzwiderstand einer Diode $T_{VJ} = T_{VJM}$	Slope resistance of a diode $T_{VJ} = T_{VJM}$
$r_T$	Ersatzwiderstand eines Thyristors $T_{VJ} = T_{VJM}$	Slope resistance of a thyristor $T_{VJ} = T_{VJM}$

**Kurzzeichen  
Letter symbols**

**herrmann**

$T_{VJ}$	Sperrschichttemperatur	Virtual junction temperature
$T_{VJM}$	Maximal zulässige Sperrschichttemperatur	Maximum junction temperature
$T_A$	Umgebungstemperatur	Ambient temperature
$T_C$	Gehäusetemperatur	Case temperature
$R_{thJC}$	Thermischer Widerstand Sperrschicht - Gehäuse (bei Konstantstrom)	Thermal resistance junction to case (at constant current)
$R_{thJA}$	Thermischer Widerstand Sperrschicht - Umgebung	Thermal resistance junction to ambient
$R_{thCK}$	Thermischer Widerstand Gehäuse - Kühlkörper	Thermal resistance case to heatsink
$R_{thKA}$	Thermischer Widerstand Kühlkörper - Umgebung	Thermal resistance heatsink to ambient
$P_{RSM}$	Stoßsperrverlustleistung bei $T_{VJM}$ und 10 ms Stromdauer	Surge reverse power dissipation at $T_{VJM}$ and 10 ms current duration
$t_q$	Freiwerdezeit für Netzfrequenz- Anwendung; typische Werte für schnelle Typen: garantierte Werte $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , linearer Anstieg, $T_{VJ} = T_{VJM}$ , $I_{TM} = I_{TAVM}$ , $di/dt = -5 \text{ A/ms}$ $dv/dt = 50 \text{ V/ms}$ $V_R = 100 \text{ V}$	Turn-off time for mains frequency types; typical values for fast turn-off types: guaranteed values $V_D = 0,67 V_{DRM}$ , linear rise, $T_{VJ} = T_{VJM}$ , $I_{TM} = I_{TAVM}$ , $di/dt = -5 \text{ A/ms}$ $dv/dt = 50 \text{ V/ms}$ $V_R = 100 \text{ V}$
$t_{rr}$	Sperrverzögerungszeit bei $T_{VJ} = T_{VJM}$ , typischer Wert	Reverse recovery time at $T_{VJ} = T_{VJM}$ , typical value
$t_{gt}$	Einschaltzeit über Steuerelektrode	Gate controlled turn on time
$Q_{rr}$	Sperrverzögerungsladung bei $T_{VJ} = T_{VJM}$ , typischer Wert	Reverse recovery charge at $T_{VJ} = T_{VJM}$ , typical value
$M_d$	Anzugsdrehmoment bei der Montage von Schraub-Bauelementen	Torque for assembly of stud-base components
$M1$	Anzugsdrehmoment Gehäuse - Kühlkörper	Torque for assembly case to heatsink
$M2$	Anzugsdrehmoment elektrische Anschlüsse	Torque for assembly of electrical connections
$F_m$	Anpreßkraft bei der Montage von Scheiben-Bauelementen	Mounting force to assembly of capsule components
X	Inverse Polung	Inverse polarity
A	Anodenanschluß	Anode terminal
K	Kathodenanschluß	Cathode terminal
H	Hilfskathodenanschluß	Auxiliary cathode terminal
G	Anschluß der Steuerelektrode	Gate terminal
$G_1$	Anschluß der Steuerelektrode (Zusatzanschluß)	Gate terminal (additional)